

・国内・外国特許（出願件数：41件，登録件数：24件）

#### 登録済外国特許

1. Tetsuya Akasaka, Seigo Ando, Toshio Nishida, Naoki Kobayashi and Tadashi Saitoh, “Thin film deposition method of nitride semiconductor and nitride semiconductor light emitting device”, US6,920,166（2005年7月19日登録），出願番号 US 10/390,358, 公開日 2005年7月19日, 出願日 2003年3月17日.

#### 登録済国内特許

2. 赤坂哲也, 小林康之, 安藤精後, 小林直樹, “半導体微小構造体の製造方法”, 特許第 327074号 (2002年1月18日登録), 特願平 9-54585, 特開平 10-256151 (1998年9月25日公開).
3. 松岡隆志, 赤坂哲也, “原子間力顕微鏡、トンネル顕微鏡又はスピン偏極トンネル顕微鏡に用いる探針及びカンチレバー並びにその作製法”, 特許第 3441051号 (2003年6月20日登録), 特願平 10-099445, 特開平 11-295326 (1999年10月29日公開).
4. 赤坂哲也, 安藤精後, 小林直樹, “窒化物半導体光素子及びその製造方法”, 特許第 3521186号 (2004年2月13日登録), 特願平 11-247794, 特開 2001-077463 (2001年03月23日公開).
5. 赤坂哲也, 安藤精後, 西田敏夫, 小林直樹, “窒化物半導体の作製方法”, 特許第 3626737号 (2004年12月10日登録), 特願 2002-073027, 特開 2003-273021 (2003年09月26日公開).
6. 赤坂哲也, 安藤精後, 西田敏夫, 齊藤久夫, 小林直樹, “窒化物半導体成長方法および窒化物半導体発光素子”, 特許第 3646872号 (2005年2月18日登録), 特願 2001-018063, 特開 2002-118326 (2002年04月19日公開).
7. 赤坂哲也, 安藤精後, 山内喜晴, 小林直樹, “半導体レーザ”, 特許第 3649656号 (2005年2月25日登録), 特願 2000-176448, 特開 2001-358401 (2001年12月26日公開).
8. 赤坂哲也, 安藤精後, 西田敏夫, 齊藤 正, 小林直樹, “窒化物半導体の薄膜形成方法および窒化物半導体発光素子”, 特許第 3898537号 (2007年1月5日登録), 特願 2002-077058, 特開 2003-273472 (2003年09月26日公開).
9. 小林康之, 赤坂哲也, 牧本俊樹, “半導体膜の製造方法および半導体膜の製造装置”, 特許第 4358143号 (2009年8月14日登録), 特願 2005-093164, 特開 2006-278571 (2006年10月12日公開).
10. 赤坂哲也, 小林康之, 牧本俊樹, “窒化物半導体”, 特許第 4519693号 (2010年5月28日登録), 特願 2005-093162, 特開 2006-278569 (2006年10月12日公開).
11. 赤坂哲也, 牧本俊樹, 熊倉一英, 広木正伸, 横山春喜, 小林 隆, “窒化物半導体薄膜およびその製造方法”, 特許第 4535935号 (2010年6月25日登録), 特願 2005-146974, 特開 2006-324512 (2006年11月30日公開).
12. 小林康之, 日比野浩樹, 赤坂哲也, 牧本俊樹, “半導体積層構造及びその製造方法”, 特許第 4764260号 (2011年6月17日登録), 特願 2006-160276, 特開 2007-329354 (2007年12月20日公開).

13. 赤坂哲也, 小林康之, “窒化ホウ素の単結晶薄膜構造およびその製造方法”, 特許第 4860665 号 (2011 年 11 月 11 日登録), 特願 2008-153465, 特開 2009-298628 (2009 年 12 月 24 日公開).
14. 赤坂哲也, 小林康之, 牧本俊樹, “窒化物半導体の製造方法”, 特許第 4884157 号 (2011 年 12 月 16 日登録), 特願 2006-280425, 特開 2008-98512 (2008 年 4 月 24 日公開).
15. 小林康之, 赤坂哲也, “六方晶窒化ホウ素構造および製造方法”, 特許第 4916486 号 (2012 年 2 月 3 日登録), 特願 2008-153318, 特開 2009-298626 (2009 年 12 月 24 日公開).
16. 西川 敦, 牧本俊樹, 熊倉一英, 赤坂哲也, “窒化物半導体構造”, 特許第 4986472 号 (2012 年 5 月 11 日登録), 特願 2006-35635, 特開 2007-214515 (2009 年 8 月 23 日公開).
17. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数 誠, “窒化物半導体構造”, 特許第 5095653 号 (2012 年 9 月 28 日登録), 特願 2009-070609, 特開 2010-222174 (2010 年 10 月 7 日公開).
18. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数 誠, “窒化物半導体薄膜およびその成長方法”, 特許第 5313976 号 (2013 年 7 月 12 日登録), 特願 2010-181031, 特開 2012-41201 (2012 年 3 月 1 日公開).
19. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数 誠, “窒化物半導体薄膜の成長方法および窒化物半導体規則混晶”, 特許第 5340984 号 (2013 年 8 月 16 日登録), 特願 2010-031813, 特開 2011-171394 (2011 年 9 月 1 日公開).
20. 赤坂哲也, 嘉数 誠, “ダイヤモンド薄膜及びその製造方法”, 特許第 5346052 号 (2013 年 8 月 23 日登録), 特願 2011-051756, 特開 2011-157268 (2011 年 8 月 18 日公開).
21. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数 誠, “窒化物半導体構造”, 特許第 5451796 号 (2014 年 1 月 10 日登録), 特願 2012-049445, 特開 2012-182459 (2012 年 9 月 20 日公開).
22. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数 誠, “窒化物半導体薄膜の成長方法”, 特許第 5458037 号 (2014 年 1 月 17 日登録), 特願 2011-033330, 特開 2012-171816 (2012 年 9 月 10 日公開).
23. 小林康之, 赤坂哲也, “六方晶窒化ホウ素構造”, 特許第 5498315 号 (2014 年 3 月 14 日登録), 特願 2010-182402, 特開 2012-41221 (2012 年 3 月 1 日公開).
24. 廣木正伸, 熊倉一英, 小林康之, 赤坂哲也, 山本秀樹, 牧本俊樹, “窒化物半導体装置の製造方法”, 特許 5931803 号 (2016 年 5 月 13 日登録), 特願 2013-121748, 特開 2014-239179 (2014 年 12 月 18 日公開).